Содержание драгоценных металлов

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт транзисторов

золото 0,3636 г. г.

Драгоценных металлов на выводах не содержится.

Содержание цветных металлов

Цветных металлов не содержится.

Сведения о приемке

Транзисторные пары КТС3103АI, КТС3103БI соответствуют техническим условиям аА0.336.221 ТУ.

Штамп ОТК

Штамп Государственной приемки

Перепроверка произведена _____

Штамп ОТК

Штамп Государственной приемки

Инв.№20-1

4

ТРАНЗИСТОРНАЯ ПАРА ТИПОВ: КТС3103АI КТС3103БI

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарно-эпитаксиальные усилительные СВЧ транзисторные пары типов КТС3103АI, КТС3103БI в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в дифференциальных усилительных каскадах и других схемах радиоэлектронной аппаратуры.

Вид климатического исполнения УХЛ 2.1; 5.1.

Схема электрическая принципиальная

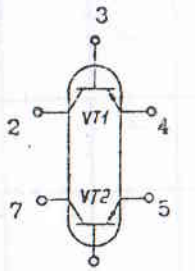
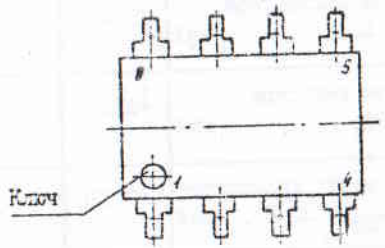


Схема расположения выводов



Инв.№20-1

1

conector.by

Таблица назначения выводов

Нумерация вывода	Назначение вывода
2	Коллектор транзистора VT1
3	База транзистора VT1
4	Эмиттер транзистора VT1
5	Эмиттер транзистора VT2
6	База транзистора VT2
7	Коллектор транзистора VT2

Основные электрические параметры
при t = (25 ± 10) °С

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		КТС3103АI		КТС3103БI	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ}$ = 15 В), мкА	$I_{КБО}$		0,2		0,2
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}$ = 5 В), мкА	$I_{ЭБО}$		0,5		0,5
Ток утечки между транзисторами ($U_{Т1Т20}$ = 20 В), мкА	$I_{Т1Т20}$		0,1		0,1
Статический коэффициент передачи тока ($I_Э$ = 1 мА, $U_{КБ}$ = 1 В, $f \leq$ 50 Гц, $t_и \leq$ 2 мс)	$h_{219\,1,2}$	40	200	40	200

Продолжение

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		КТС3103АI		КТС3103БI	
		не менее	не более	не менее	не более
Отношение статических коэффициентов передачи тока ($I_Э$ = 1 мА, $U_{КБ}$ = 1 В)	$\frac{h_{219\,1}}{h_{219\,2}}$	0,9		0,8	
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($I_Э$ = 3 мА, $U_{КБ}$ = 5 В, f = 100 МГц)	$\lvert h_{21Э} \rvert$	6		6	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_К$ = 10 мА, $I_Б$ = 1 мА), В	$U_{КЭ\,нас}$		0,6		0,6
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ}$ = 5 В), пФ	$C_К$		2,5		2,5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ}$ = 0 В), пФ	$C_Э$		2,5		2,5
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($I_Э$ = 3 мА, $U_{КБ}$ = 5 В), пс	$\tau_к$		80		80
Модуль разности прямых напряжений эмиттер-база ($I_Э$ = 1 мА, $U_{КБ}$ = 5 В), мВ	$\lvert U_{ЭБ1} - U_{ЭБ2} \rvert$		3		5

conector.by